中華民國專利公報 [19] [12]

[11]公告編號:503447

[44]中華民國 91年 (2002) 09月 21日

發明

全14頁

[51] Int.Cl ⁰⁷: H01L21/00

[54]名 稱:影像顯示裝置之製造方法和製造裝置

[21]申請案號: 090106790 [22]申請日期: 中華民國 90年 (2001) 03月22日

[30]優先權: [31]2000-081482 [32]2000/03/23 [33]日本 [31]2000-298028 [32]2000/09/29 [33]日本

[72]發明人:

金子哲也日本

中田耕平日本

宮崎俊彦 日本

[71]申請人:

佳能股份有限公司 日本

[74]代理人: 林志剛 先生

1

2

[57]申請專利範圍:

1.一種影像顯示裝置之製造方法,包含 之步驟為連續傳送用以構成影像顯 示裝置之板之一板構件分別至安裝 有溫度控制機構之多數降壓處理 室,使該板構件受到多數處理並控 制溫度,和密封該板構件藉以形成 該板,

其中該多數處理室包括一烘烤處理 室以用於該板構件之烘烤處理和一 吸氣處理室以在該烘烤處理後使經 傳送之該板構件受到吸氣處理,和 該吸氣處理乃是在吸氣處理室中之 板構件設定在溫度低於板構件受到 在烘烤處理室中之烘烤處理之溫度 之條件下執行。

2.如申請專利範圍第1項之影像顯示裝置之製造方法,其中該多數處理室包括一先前室,該板構件在傳送至吸氣處理室之前,在烘烤處理室中烘烤後,傳送至該先前室,且該先

前室鄰近該吸氣處理室,和該先前室之內部和該吸氣處理室之內部設 定之壓力不高於10⁻⁴Pa。

- 3.一種影像顯示裝置之製造方法,包含 2步驟為連續傳送用以構成影像顯 示裝置之板之一板構件分別至安裝 有溫度控制機構之多數降壓處理 室,使該板構件受到多數處理並控 制溫度,和密封該板構件藉以形成 10. 該板,
- 其中該多數處理室包括一烘烤處理 室以用於該板構件之烘烤處理,一 表面清潔室以在該板構件在該烘烤 處理後傳送至該表面清潔處理室以
- 進行表面清潔處理,和一吸氣處理室以在表面清潔處理後傳送該板構件至吸氣處理室而進行吸氣處理,和該吸氣處理乃是在吸氣處理室中之板構件設定在溫度低於板構件受到在烘烤處理室中之烘烤處理之溫

度下執行。

- 4.如申請專利範圍第3項之影像顯示裝 置之製造方法,其中該多數處理室 包括一先前室,該板構件在傳送至 吸氣處理室之前,在表面清潔處理 室中表面清潔後,傳送至該先前 室,且該先前室之內部和該吸氣處理 室之內部設定之壓力不高於 10-4Pa。
- 5.如申請專利範圍第3項之影像顯示裝 置之製造方法,其中該表面清潔處 理室鄰近該吸氣處理室,和該表面 清潔處理室之內部和該吸氣處理室 之內部設定之壓力不高於 10-4Pa。
- 6.如申請專利範圍第3至5項任一項之 影像顯示裝置之製造方法,其中該 表面清潔處理為以一電子東照射所 傳送構件表面之處理,藉以清潔該 構件之表面。
- 7.如申請專利範圍第3至5項任一項之 影像顯示裝置之製造方法,其中該 表面清潔處理為以離子照射所傳送 **構件表面之處理,藉以清潔該構件** 之表面。
- 8.如申請專利範圍第3至5項任一項之 影像顯示裝置之製造方法,其中該 表面清潔處理為以紫外線照射所傳 送構件表面之處理,藉以清潔該機 件之表面。
- 9.如申請專利範圍第3至5項任一項之 影像顯示裝置之製造方法,其中該 表面清潔處理為以電漿照射所傳送 構件表面之處理,藉以清潔該構件 之表面。
- 10.如申請專利範圍第1,2,3,4, 或5項之任一項之影像顯示裝置之製 造方法,其中該吸氣處理室內部之 吸氣處理進一步在該吸氣處理中執 行。
- 11.如申請專利範圍第1,2,3,4, 或5項之任一項之影像顯示裝置之製

- 造方法,其中該板構件以板構件設 定在溫度高於板構件受到在吸氣處 理室中之吸氣處理之溫度下密封。
- 12.一種影像顯示裝置之製造方法,包 5. 含之步驟為連續傳送用以構成影像 顯示裝置之板之一板構件分別至安 裝有溫度控制機構之多數降壓處理 室,使該板構件受到多數處理並控 制溫度,和密封該板構件藉以形成 10. 該板,
- 其中該多數處理室包括一烘烤處理 室以用於該板構件之烘烤處理;第 一吸氣處理室,在該烘烤處理後將 板構件傳送至第一吸氣處理室,日 15. 其中在該處理室內部執行吸氣處 理;和第二吸氣處理室,在吸氣處 理後傳送該板構件至第二吸氣處理 室,其中在該板構件上執行吸氣處 理,和其鄰近第一吸氣處理室,和 該板構件之吸氣處理乃是在第二吸 氣處理室中之板構件設定在溫度低 於板構件受到在烘烤處理室中之烘 烤處理之溫度下執行。
- 13.如申請專利範圍第12項之影像顯示 25. 裝置之製造方法, 其中該多數處理室包括一先前室, 該板構件在傳送至第一吸氣處理室 之前,在烘烤處理室中烘烤後,傳 送至該先前室,且該先前室鄰近該 30. 第一吸氣處理室,和該先前室之內 部和該第一和第二吸氣處理室之內 部設定之壓力不高於 10⁴Pa。
- 14.一種影像顯示裝置之製造方法,包 含之步驟為連續傳送用以構成影像 35. 顯示裝置之板之一板構件分別至安 裝有溫度控制機構之多數降壓處理 室,使該板構件受到多數處理並控 制溫度,和密封該板構件藉以形成 該板,
- 40. 其中該多數處理室包括一烘烤處理

室以用於該板構件之烘烤處理;一 表面清潔室以在該板構件在該烘烤 處理後傳送至該表面清潔處理室以 進行表面清潔處理;第一吸氣處理 室,在該表面清潔處理後將板構件 傳送至第一吸氣處理室以進行第一 吸氣處理室內部之吸氣處理;和第 二吸氣處理室,在第一吸氣處理室 內部之吸氣處理後將板構件傳送至 第二吸氣處理室以進行板構件之吸 氣處理,該第二吸氣處理室鄰近第 一吸氣處理室,和該板構件之吸氣 處理以在第二吸氣處理室中之板構 件之溫度設定成低於板構件受到在 烘烤處理室中之烘烤處理之溫度下 執行。

- 15.如申請專利範圍第14項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理室鄰近第一吸氣處理室,和該 表面清潔處理室之內部和該第一和 第二吸氣處理室之內部設定之壓力 不高於10⁴Pa。
- 16.如申請專利範圍第14或15項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以一電子束照射所傳送 構件表面之處理,藉以清潔該構件 之表面。
- 17.如申請專利範圍第14或15項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以離子照射所傳送構件 表面之處理,藉以清潔該構件之表 面。
- 18.如申請專利範圍第14或15項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以紫外線照射所傳送構 件表面之處理,藉以清潔該構件之 表面。
- 19.如申請專利範圍第14或15項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以電漿照射所傳送構件

表面之處理,藉以清潔該構件之表面。

- 20.如申請專利範圍第12至15項之任一項之影像顯示裝置之製造方法,
- 5. 其中該板構件乃在溫度設定成高於 板構件受到在第二吸氣處理室中之 吸氣處理之溫度下密封。
- 21.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為連續傳送用以構成影像 10. 顯示裝置之板之一板構件分別至安裝有溫度控制機構之多數降壓處理室,使該板構件受到多數處理並控制溫度,和密封該板構件藉以形成該板,
- 15. 其中該多數處理室包括一烘烤處理 室以用於該板構件之烘烤處理;一 冷卻處理室,在該烘烤處理後將板 構件傳送至冷卻處理室以對該板構 件進行冷卻處理;和一吸氣處理 20. 室,以在該冷卻處理後,傳送該板 構件至該吸氣處理室以對該板構件 進行吸氣處理。
 - 22.如申請專利範圍第21項之影像顯示裝置之製造方法,
- 25. 其中該多數處理室包括一先前室, 該板構件在傳送至吸氣處理室之 前,在冷卻處理室中冷卻後,傳送 至該先前室,且該先前室鄰近該吸 氣處理室,和該先前室之內部和該 30. 吸氣處理室之內部設定之壓力不高
- 於 10⁴Pa。 23.如申請專利範圍第21項之影像顯示

裝置之製造方法,

- 其中該冷卻處理室鄰近該吸氣處理 35. 室,和該冷卻處理室之內部和該吸 氣處理室之內部設定之壓力不高於 10⁴Pa。
- 24.如申請專利範圍第21至23項之任一 項之影像顯示裝置之製造方法,其 40. 中該吸氣處理室內部之吸氣處理進

- 一步在該吸氣處理室中執行。
- 25.如申請專利範圍第21至23項之任一項之影像顯示裝置之製造方法,其中該板構件之表面清潔處理進一步在該冷卻處理室中執行。
- 26.如申請專利範圍第21至23項之任一項之影像顯示裝置之製造方法,其中該冷卻處理室內部之吸氣處理進一步在該冷卻處理室中執行。
- 27.如申請專利範圍第25項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該冷卻處理 室內部之吸氣處理進一步在該冷卻 處理室中執行。
- 28.如申請專利範圍第25項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以一電子束照射所傳送構件 表面之處理,藉以清潔該構件之表 面。
- 29.如申請專利範圍第25項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以離子照射所傳送構件表面 之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 30.如申請專利範圍第25項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以紫外線照射所傳送構件表 面之處理,藉以清潔該機件之表 面。
- 31.如申請專利範圍第25項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以電漿照射所傳送構件表面 之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 32.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為連續傳送用以構成影像顯示裝置之板之一板構件分別至安裝有溫度控制機構之多數降壓處理室,使該板構件受到多數處理並控制溫度,和密封該板構件藉以形成該板,

其中該多數處理室包括一烘烤處理 室以用於該板構件之烘烤處理;一

- 冷卻處理室,在該烘烤處理後將板 構件傳送至冷卻處理室以對該板構 件進行冷卻處理;一表面清潔處理 室,在該冷卻處理後將板構件傳送 至表面清潔處理室以進行表面清潔 處理;和一吸氣處理室,以在該表 面清潔處理後,傳送該板構件至該 吸氣處理室以對該板構件進行吸氣 處理。
- 10. 33.如申請專利範圍第32項之影像顯示裝置之製造方法, 其中該多數處理室包括一先前室, 該板構件在傳送至吸氣處理室之前,在表面清潔處理室中表面清潔 處理後,傳送至該先前室,且該先前室鄰近該吸氣處理室,和該先前室之內部和該吸氣處理室之內部設定之壓力在10-4Pa或更降壓位準。
- 34.如申請專利範圍第32項之影像顯示 20. 裝置之製造方法, 其中該表面清潔處理室鄰近該吸氣 處理室,和該表面清潔處理室之內 部和該吸氣處理室之內部設定之壓 力在10-4Pa或更降壓位進。
- 25. 35.如申請專利範圍第32至34項任一項 之影像顯示裝置之製造方法,其中 該吸氣處理室內部之吸氣處理進一 步在該吸氣處理室中執行。
- 36.如申請專利範圍第32至34項任一項 30. 之影像顯示裝置之製造方法,其中 該表面清潔處理為以一電子東照射 所傳送構件表面之處理,藉以清潔 該構件之表面。
- 37.如申請專利範圍第32至34項任一項 35. 之影像顯示裝置之製造方法,其中 該表面清潔處理為以離子照射所傳 送構件表面之處理,藉以清潔該構 件之表面。
- 38.如申請專利範圍第32至34項任一項 40. 之影像顯示裝置之製造方法,其中

10.

該表面清潔處理為以紫外線照射所 傳送構件表面之處理,藉以清潔該 構件之表面。

- 39.如申請專利範圍第32至34項任一項 之影像顯示裝置之製造方法,其中 該表面清潔處理為以電漿照射所傳 送構件表面之處理,藉以清潔該構 件之表面。
- 40.如申請專利範圍第 21 , 22 , 23 , 32 , 33 , 或34 項之影像顯示裝置之製造方法,其中該板構件之密封乃在板構件設定在溫度高於板構件在該吸氣處理室中受到吸氣處理之溫度下執行。
- 41.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為連續傳送用以構成影像顯示裝置之板之一板構件分別至安裝有溫度控制機構之多數降壓處理室,使該板構件受到多數處理並控制溫度,和密封該板構件藉以形成該板,

其中該多數處理室包含:

- 一烘烤處理室以用於該板構件之烘 烤處理;
- 一冷卻處理室,在該烘烤處理後將 板構件傳送至冷卻處理室以對該板 構件進行冷卻處理;

第一吸氣處理室,在冷卻處理後, 對板構件所傳送至之吸氣處理室內 部進行吸氣處理;和

- 第二吸氣處理室,在吸氣處理後, 將該板構件傳送至該第二吸器處理 室以進行對板構件之吸氣處理,和 第二吸氣處理室鄰近第一吸氣處理 室。
- 42.如申請專利範圍第41項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該冷卻處理 室鄰近第一吸氣處理室,和該冷卻 處理室之內部和該第一和第二吸氣 處理室之內部設定之壓力在104Pa或

更降壓位準。

- 43.如申請專利範圍第41或42項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該板構 件之表面清潔處理進一步在該冷卻 處理室中執行。
- 44.如申請專利範圍第43項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以一電子束照射所傳送構件 表面之處理,藉以清潔該構件之表 面。
- 45.如申請專利範圍第43項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以離子照射所傳送構件表面 之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 15. 46.如申請專利範圍第43項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以紫外線照射所傳送構件表 面之處理,藉以清潔該構件之表 面。
- 20. 47.如申請專利範圍第43項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該表面清潔 處理為以電漿照射所傳送構件表面 之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 48.一種影像顯示裝置之製造方法,包 25. 含之步驟為連續傳送用以構成影像 顯示裝置之板之一板構件分別至安 裝有溫度控制機構之多數降壓處理 室,使該板構件受到多數處理並控 制溫度,和密封該板構件藉以形成 30. 該板,

其中該多數處理室包含:

- 一烘烤處理室以用於該板構件之烘 烤處理;
- 一冷卻處理室,在該烘烤處理後將 35. 板構件傳送至冷卻處理室以對該板 構件進行冷卻處理;
 - 一表面清潔處理室,在該冷卻處理 後,將板構件傳送至表面清潔處理 室以對板構件進行表面清潔處理;
- 40. 第一吸氣處理室,在表面清潔處理

15.

20.

- 後,對板構件所傳送至之吸氣處理室內部進行吸氣處理;和 第二吸氣處理室,在吸氣處理後,將該板構件傳送至該第二吸器處理室以進行對板構件之吸氣處理,和第二吸氣處理室鄰近第一吸氣處理
- 49.如申請專利範圍第48項之影像顯示 裝置之製造方法, 其中該表面清潔處理室鄰近第一吸 氣處理室,和該表面清潔處理室之 內部和該第一和第二吸氣處理室之 內部設定之壓力在10⁴Pa或更降壓位 進。

室。

- 50.如申請專利範圍第48或49項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以一電子東照射所傳送 構件表面之處理,藉以清潔該構件 之表面。
- 51.如申請專利範圍第48或49項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以離子照射所傳送構件 表面之處理,藉以清潔該構件之表 面。
- 52.如申請專利範圍第48或49項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以紫外線照射所傳送構 件表面之處理,藉以清潔該構件之 表面。
- 53.如申請專利範圍第48或49項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該表面 清潔處理為以電漿照射所傳送構件 表面之處理,藉以清潔該構件之表 面。
- 54.如申請專利範圍第41或48項之影像 顯示裝置之製造方法,其中該板構 件之密封乃是在板構件設定在溫度 高於板構件在第二吸氣處理室中受 到吸氣處理之溫度下執行。
- 55.如申請專利範圍第1,3,12,14,

- 21,32,41,或48項任一項之影 像顯示裝置之製造方法,其中該板 構件具有一面板以組成該板之一顯 示表面,且密封至一背板,該背板 設置以一間隙相對該面板,以構成 該板之背表面。
- 56.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中第一密封材 料設置在該背板之側上以密封至該 板構件。
- 57.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中以第二密封 材料固定以構成該板之側表面之一 外框,和設置在外框上以密封至該 板構件之第一密封材料,乃設置在 該背板側上。
- 58.如申請專利範圍第57項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
- 59.如申請專利範圍第56項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 25. 60.如申請專利範圍第56項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 61.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該板構件進 60. 一步具有第一密封材料設置在該面 板上,且以第一密封材料密封至該 背板。
- 62.如申請專利範圍第61項之影像顯示 裝置之製造方法,其中以第二密封 35. 材料固定以構成該板之側表面之一 外框乃設置在該背板之側上。
 - 63.如申請專利範圍第62項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。

25.

- 64.如申請專利範圍第61項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 65.如申請專利範圍第62項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 66.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該板構件淮 一步具有一外框,該外框以第二密 封材料固定至該面板以構成該板之 側表面且密封至該背板。
- 67.如申請專利範圍第66項之影像顯示 裝置之製造方法,其中密封至該板 構件之第一密封材料乃設置在該背 板側上。
- 68.如申請專利範圍第67項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
- 69.如申請專利範圍第67項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 70.如申請專利範圍第56項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 71.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該板構件進 一步具有一外框,該外框以第二密 封材料固定至該面板以構成該板之 側表面,和設置在該外框上之第一 密封材料,和該板構件以第一密封 材料密封至該背板。
- 72.如申請專利範圍第71項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
- 73.如申請專利範圍第71項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封

- 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 74.如申請專利範圍第71項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
 - 75.如申請專利範圍第1,3,12,14, 21, 32, 41, 或48項任一項之影 像顯示裝置之製造方法,其中該板 構件具有一背板設置以相對構成該 板之一顯示表面之一面板,以構成
- 10. 該板之背表面,和密封至該面板。
 - 76.如申請專利範圍第75項之影像顯示 裝置之製造方法,其中密封至該板 構件之第一密封材料設置在該面板 之側上。
 - 77.如申請專利範圍第75項之影像顯示 裝置之製造方法,其中以第二密封 材料固定以構成該板之側表面之一 外框,和設置在外框上以密封至該
- 20. 板構件之第一密封材料,乃設置在 該面板側上。
 - 78.如申請專利範圍第77項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
 - 79.如申請專利範圍第76項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 30. 80.如申請專利範圍第77項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 81.如申請專利範圍第75項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該板構件進 一步具有第一密封材料設置在該背 35. 板上,且以第一密封材料密封至該 面板。
 - 82.如申請專利範圍第81項之影像顯示 裝置之製造方法,其中以第二密封 材料固定以構成該板之側表面之一

外框乃設置在該面板之側上。

- 83.如申請專利範圍第82項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
- 84.如申請專利範圍第81項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 85.如申請專利範圍第82項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 86.如申請專利範圍第75項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該板構件進 一步具有一外框,該外框以第二密 封材料固定至該背板以構成該板之 側表面。
- 87.如申請專利範圍第86項之影像顯示 裝置之製造方法,其中密封至該板 構件之第一密封材料乃設置在該面 板側上。
- 88.如申請專利範圍第87項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
- 89.如申請專利範圍第87項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
- 90.如申請專利範圍第86項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 91.如申請專利範圍第75項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該板構件進 一步具有一外框,該外框以第二密 封材料固定至該背板,和設置在該 外框上之第一密封材料,和該板構 件以第一密封材料密封至該面板。
- 92.如申請專利範圍第91項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封

- 材料之熔點高於第一密封材料之熔 點。
- 93.如申請專利範圍第91項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第一密封 材料為具有低熔點之金屬或該金屬 合金。
 - 94.如申請專利範圍第91項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該第二密封 材料為多孔玻璃。
- 10. 95.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該面板具有 磷。
 - 96.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該面板具有 磷和一金屬背面。
 - 97.如申請專利範圍第55項之影像顯示 裝置之製造方法,其中該背板具有 磷激勵機構。
- 98.如申請專利範圍第97項之影像顯示 20. 裝置之製造方法,其中該磷激勵機 構具有一電子發射裝置。
 - 99.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為:
- a:傳送包括設置有磷激勵機構之一 25. 基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件至充填一降壓大 氣之烘烤處理室和加熱以進行烘烤 處理;
- b:傳送第一構件和第二構件之一或 30. 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之吸氣處理室和執行所傳送構件 之一或兩者之吸氣處理;和
 - c:傳送第一構件和第二構件經由降 壓大氣至充填以降壓大氣之密封處 理家,和加熱以密封,其中在失照內
- 35. 理室,和加熱以密封,其中在步驟 b 中受到吸氣處理之構件之溫度低於 在步驟 a 中之加熱溫度。
 - 100.如申請專利範圍第 99 項之影像顯示裝置之製造方法,其中在步驟b中之吸氣處理乃是在對所傳送構件之

15.

- 一或兩者加熱時執行,和在步驟b之 加熱溫度低於在步驟a之加熱溫度。
- 101.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為:
 - a:傳送包括設置有磷激勵機構之一 基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件至充填一降壓大 氣之烘烤處理室和加熱以進行烘烤 處理;
 - b: 傳送第一構件和第二構件之一或兩者經由降壓大氣至充填以降壓大氣之冷卻處理室以冷卻;
 - c: 傳送第一構件和第二構件之一或兩者經由降壓大氣至充填以降壓大氣之吸氣處理室以對所傳送之構件之一或兩者進行吸氣處理; 和
 - d: 傳送第一構件和第二構件經由降 壓大氣至充填降壓大氣之一密封處 理室。
- 102.如申請專利範圍第101項之影像顯示裝置之製造方法,其中在步驟b中在冷卻處理室中對所傳送構件之一或兩者執行表面清潔處理。
- 103.如申請專利範圍第101項之影像顯示裝置之製造方法,其中所傳送構件之一或兩者之表面清潔處理在冷卻處理室中執行,和該冷卻處理室內部之吸氣處理在步驟b中執行。
- 104.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為:
 - a: 傳送包括設置有磷激勵機構之一基底之第一構件和包括設置有磷之一基底之第二構件至充填一降壓大氣之烘烤處理室和加熱以進行烘烤處理;
 - b: 傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之表面清潔處理室,和執行所傳 送構件之一或兩者之表面清潔處 理;

- c:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之吸氣處理室,和執行所傳送構 件之一或兩者之吸氣處理;和
- 6. d:傳送第一構件和第二構件經由降 壓大氣至充填以降壓大氣之密封處 理室和加熱以密封。
 - 105.如申請專利範圍第104項之影像顯示裝置之製造方法,其中表面清潔處理室內部之吸氣處理乃在步驟b中在表面清潔處理室中執行。
 - 106.如申請專利範圍第104或105項之 影像顯示裝置之製造方法,其中所 傳送構件之一或兩者乃在步驟b中在 表面清潔處理室中冷卻。
 - 107.如申請專利範圍第101或104項之 影像顯示裝置之製造方法,其中吸 氣處理乃是在步驟c中在所傳送構件 之一或兩者加熱時執行,和在步驟c 中之加熱溫度低於在步驟a中之加熱 溫度。
 - 108.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為:
- a: 傳送包括設置有磷激勵機構之一 25. 基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件至充填一降壓大 氣之烘烤處理室和加熱以進行烘烤 處理;
- b:傳送第一構件和第二構件之一或 30. 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之表面清潔處理室,和執行所傳 送構件之一或兩者之表面清潔處 理;
- c:傳送第一構件和第二構件之一或 35. 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之第一吸氣處理室,和執行該第 一吸氣處理室內部之吸氣處理;
- d:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 40. 氣之第二吸氣處理室,和執行所傳

送構件之一或兩者之吸氣處理;和 e:傳送第一構件和第二構件經由降 壓大氣至充填以降壓大氣之密封處 理室和加熱以密封。

- 109.如申請專利範圍第108項之影像顯示裝置之製造方法,其中所傳送構件之一或兩者在步驟b中在表面清潔處理室中冷卻。
- 110.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為:
 - a:傳送包括設置有磷激勵機構之一 基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件至充填一降壓大 氣之烘烤處理室和加熱以進行烘烤 處理;
 - b: 傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之冷卻處理室,和執行冷卻處 理;
- c:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之表面清潔處理室,和執行所傳 送構件之一或兩者之表面清潔處 理;
- d:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之吸氣處理室,和執行所傳送構 件之一或兩者之吸氣處理;和
- e: 傳送第一構件和第二構件經由降 壓大氣至充填以降壓大氣之密封處 理室和加熱以密封。
- 111.如申請專利範圍第 108至 110 項之 任一項之影像顯示裝置之製造方 法,其中吸氣處理乃是在步驟d中在 所傳送構件之一或兩者加熱時執 行,和在步驟d中之加熱溫度低於在 步驟a中之加熱溫度。
- 112.一種影像顯示裝置之製造方法,包含之步驟為:
 - a:傳送包括設置有磷激勵機構之一

- 基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件至充填一降壓大 氣之烘烤處理室和加熱以進行烘烤 處理;
- 5. b:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之冷卻處理室,和執行冷卻處 理;
- c:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之表面清潔處理室,和執行所傳 送構件之一或兩者之表面清潔處 理;
- d:傳送第一構件和第二構件之一或 同者經由降壓大氣至充填以降壓大 氣之第一吸氣處理室,和執行該第 一吸氣處理室內部之吸氣處理;
- e:傳送第一構件和第二構件之一或 兩者經由降壓大氣至充填以降壓大 20. 氣之第二吸氣處理室,和執行所傳 送構件之一或兩者之吸氣處理;和 f:傳送第一構件和第二構件經由降 壓大氣至充填以降壓大氣之密封處 理室和加熱以密封。
- 25. 113.如申請專利範圍第112項之影像顯示裝置之製造方法,其中吸氣處理乃是在步驟e中在所傳送構件之一或兩者加熱時執行,和在步驟e中之加熱溫度低於在步驟a中之加熱溫度。
- 30. 114.如申請專利範圍第102項之影像顯示裝置之製造方法,其中該表面清潔處理為以一電子東照射所傳送構件表面之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 35. 115.如申請專利範圍第102項之影像顯示裝置之製造方法,其中該表面清潔處理為以離子照射所傳送構件表面之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 40. 116.如申請專利範圍第102項之影像顯

示裝置之製造方法,其中該表面清 潔處理為以紫外線照射所傳送構件 表面之處理,藉以清潔該構件之表 面。

- 117.如申請專利範圍第102項之影像顯示裝置之製造方法,其中該表面清潔處理為以電漿照射所傳送構件表面之處理,藉以清潔該構件之表面。
- 118.如申請專利範圍第99,101, 104,108,110,或112項之影像顯 示裝置之製造方法,其中該第一構 件具有一基底,其上設置磷激勵機 構,和一外框。
- 119.如申請專利範圍第 99 ,101 , 104 ,108 ,110 ,或112項之影像顯 示裝置之製造方法,其中該第一構 件具有一基底,其上設置磷激勵機 構,和一間隔器。
- 120.如申請專利範圍第99,101, 104,108,110,或112項之影像顯 示裝置之製造方法,其中該第一構 件具有一基底,其上設置磷激勵機 構,一外框,和一間隔器。
- 121.如申請專利範圍第99,101, 104,108,110,或112項之影像顯 示裝置之製造方法,其中該第二構 件具有一基底,其上設置磷,和一 外框。
- 122.如申請專利範圍第99,101, 104,108,110,或112項之影像顯 示裝置之製造方法,其中該第二構 件具有一基底,其上設置磷,和一 間隔器。
- 123.如申請專利範圍第99,101, 104,108,110,或112項之影像顯示裝置之製造方法,其中該第二構件具有一基底,其上設置磷,一外框,和一間隔器。
- 124.如申請專利範圍第99,101,

- 104,108,110,或112項之影像顯示裝置之製造方法,其中使用於吸氣處理之吸氣劑為一蒸發吸氣劑。
- 125.如申請專利範圍第99 ,101 , 5. 104 ,108 ,110 ,或112項之影像顯 示裝置之製造方法,其中該磷激勵 機構具有一電子發射裝置。
 - 126.一種影像顯示裝置之製造裝置,包含:
- 10. 一吸氣處理室,用以在真空下執行 包括設置有磷激勵機構之一基底之 第一構件和包括設置有磷之一基底 之第二構件之一或兩者之吸氣處 理;
- 15. 一密封處理室,用以藉由對第一構件和第二構件加熱而執行密封處理;和傳送機構,其可傳送該第一構件和第二構件從吸氣處理室至密封處理20. 室,
- 工 其中在吸氣處理室和密封處理室間 設置有一熱屏蔽構件。
 - 127.一種影像顯示裝置之製造裝置,包含:
- 25. 一烘烤處理室,用以在真空下以加 熱執行包括設置有磷激勵機構之一 基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件之烘烤處理; 一吸氣處理室,用以執行第一構件
- 30. 和第二構件之一或兩者之吸氣處理;和

傳送機構,其可傳送該第一構件和 第二構件從烘烤處理室至吸氣處理 室,

- 35. 其中在烘烤處理室和吸氣處理室間 設置有一熱屏蔽構件。
 - 128.一種影像顯示裝置之製造裝置,包含:
- 一烘烤處理室,用以在真空下以加 40. 熱執行包括設置有磷激勵機構之一

基底之第一構件和包括設置有磷之 一基底之第二構件之烘烤處理;

一吸氣處理室,用以執行第一構件 和第二構件之一或兩者之吸氣處 理;

一密封處理室,用以藉由對第一構件和第二構件之一或兩者加熱以執行密封處理;和

傳送機構,其可傳送該第一構件和 第二構件依序至烘烤處理室,吸氣 處理室,和密封處理室,

其中在處理室間設置有熱屏蔽構 件。

- 129.如申請專利範圍第 126 至 128 項任 一項之影像顯示裝置之製造裝置, 其中該熱屏蔽構件以反射性金屬製 成。
- 130.一種影像顯示裝置之製造裝置,包含:

一烘烤處理室,用以在降壓大氣下 以加熱執行包括設置有磷激勵機構 之一基底之第一構件和包括設置有 磷之一基底之第二構件之烘烤處 理;

一冷卻處理室,用以緩慢的冷卻第一構件和第二構件之一或兩者;

一吸氣處理室,用以執行第一構件 和第二構件之一或兩者之吸氣處 理;和

傳送機構,其可傳送該第一構件和 第二構件依序至烘烤處理室,冷卻 處理室,和吸氣處理室。

131.一種影像顯示裝置之製造裝置,包含:

一烘烤處理室,用以在降壓大氣下 以加熱執行包括設置有磷激勵機構 之一基底之第一構件和包括設置有 磷之一基底之第二構件之烘烤處 理;

一冷卻處理室,用以緩慢的冷卻第

- 一構件和第二構件之一或兩者;
- 一吸氣處理室,用以執行第一構件 和第二構件之一或兩者之吸氣處 理;
- 5. 一密封處理室,用以藉由對第一構 件和第二構件加熱而執行密封處 理;和

傳送機構,其可傳送該第一構件和 第二構件依序至烘烤處理室,冷卻 處理室,吸氣處理室,和密封處理

- 室。
 132.如申請專利範圍第130或131項之
 影像顯示裝置之製造裝置,其中一
 熱屏蔽構件設置在該烘烤處理室和
- 15. 冷卻處理室間。 133.如申請專利範圍第131項之影像顯 示裝置之製造裝置,其中一熱屏蔽 構件設置在該吸氣處理室和密封處 理室間。
- 20. 134.如申請專利範圍第131項之影像顯示裝置之製造裝置,其中一熱屏蔽構件設置在該烘烤處理室和冷卻處理室間,和一熱屏蔽構件設置在該吸氣處理室和密封處理室間。
- 25. 135.如申請專利範圍第130或131項之 影像顯示裝置之製造裝置,其中一 熱屏蔽構件設置在處理室間。
 - 136.如申請專利範圍第132項之影像顯示裝置之製造裝置,其中該熱屏蔽構件以反射性金屬製成。
 - 137.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該第一構件 具有一基底,其上設置有磷激勵機 構,和一外框。
 - 138.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該第一構件 具有一基底,其上設置有磷激勵機
- 40. 構,和一間隔器。

30.

- 139.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該第一構件 具有一基底,其上設置有磷激勵機 構,一外框,和一間隔器。
- 140.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該第二構件 具有一基底,其上設置有磷,和一 外框。
- 141.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該第二構件 具有一基底,其上設置有磷,和一 間隔器。
- 142.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該第二構件

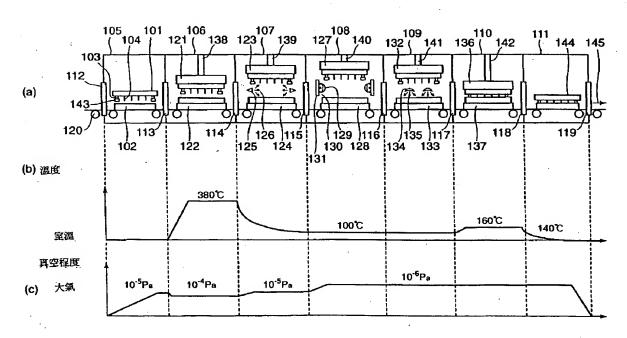
- 具有一基底,其上設置有磷,一外 框,和一間隔器。
- 143.如申請專利範圍第126至128, 130,或131項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中使用於吸氣 處理之吸氣劑為一蒸發吸氣劑。
 - 144.如申請專利範圍第 126 至 128 , 130 ,或 131 項之任一項之影像顯示 裝置之製造裝置,其中該磷激勵機 構具有一電子發射裝置。

圖式簡單說明:

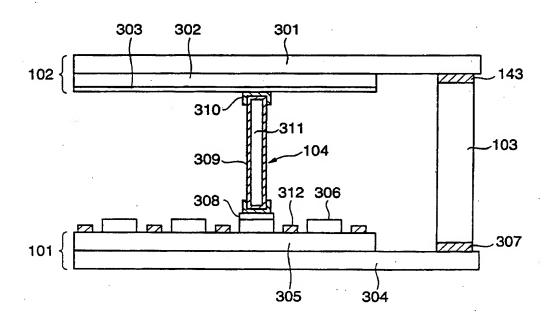
圖1為依照本發明之製造裝置之 示意圖,在製造裝置中之板構件之溫 度輪廓,和在製造裝置之室中之真空

15. 程度輪廓圖;和

圖2為影像顯示裝置之部份截面 圖,該影像顯示裝置由依照本發明之 製造方法和製造裝置所製造。



第1圖



第2圖